

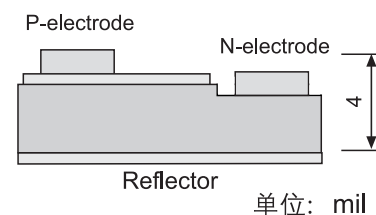
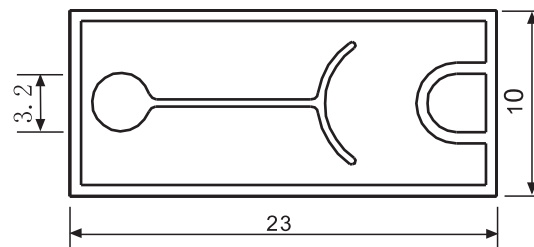


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	23mil x 10mil (584 ± 25μm x 254 ± 25μm)
芯片厚度	4.0mil (100 ± 15μm)
焊盘尺寸	3.2mil (80 ± 10μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: (T_C=22°C, I_F=20mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
S-23ABMUP*-445E**	445	450	2.8-3.0	≤2	≤30	30
S-23ABMUP*-450E**	450	455				
S-23ABMUP*-455E**	455	460				
S-23ABMUP*-460E**	460	465				
S-23ABMUP*-465E**	465	470				
S-23ABMUP*-470E**	470	475				

◆ 光强等级: (T_C=22°C, I_F=20mA)

等级	G2	H1	I1	I2	J1	J2	K1	K2	...
I _V 范围(mcd)	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-270	270-300	...

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于280°C, 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片